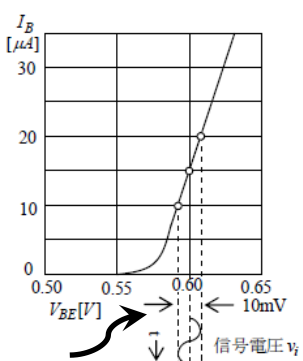
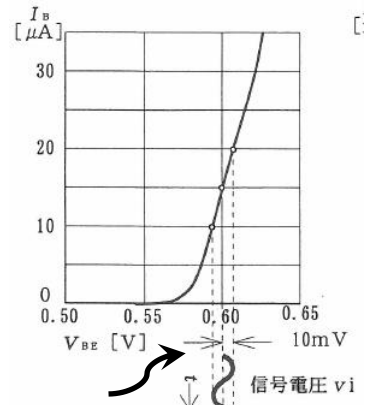


訂正表

2022年02月10日現在

ページ	訂正箇所	訂正内容	掲載日
P. 26	[No. 31] 問題文 肢⑤	誤 ⑤ <u>EEPROM</u> と同じ原理。比較的大きなブロック単位で蓄積情報の変更を行うため、安価となっている。不揮発性なのでデジタルカメラや携帯電話用のデータ蓄積用に広く使われている。	2022/02/10
		正 ⑤ <u>EEPROM</u> の一種である。 <u>EEPROM</u> と比べて大きなブロック単位で蓄積情報の変更を行うため、安価となっている。不揮発性なのでデジタルカメラや携帯電話用のデータ蓄積用に広く使われている。	
P. 31	[No. 37] 問題文 3, 7行目	誤 「RAM (Random Access Memory) に使われる物質には様々なものがあるが、その中のひとつに強誘電体を用いた <u>FRAM</u> がある。…… …… これをデジタルの0と1に対応させることにより、情報を記憶する。 <u>FRAM</u> は、	2022/02/10
		正 「RAM (Random Access Memory) に使われる物質には様々なものがあるが、その中のひとつに強誘電体を用いた <u>FeRAM</u> がある。…… …… これをデジタルの0と1に対応させることにより、情報を記憶する。 <u>FeRAM</u> は、	
P. 37	[No. 52] 問題文 4~5行目	誤 図2より、この増幅回路の電圧増幅率は A , 電流増幅率は B である。	2022/02/10
		正 図2より、この増幅回路の電圧増幅度は A , 電流増幅度は B である。	
P. 37	[No. 52] 図1の右下の左側の矢印	誤  図1 $V_{BE} - I_B$ 特性	2022/02/10
		正  図1 $V_{BE} - I_B$ 特性	

P. 77	[No. 32] 解説の①	誤	① nチャンネル型とpチャンネル型があるのは接合型FETである。(pチャンネル型は、ソース電極とドレイン電極をp型にして、ゲート電極をn型にする。)	2022/02/10
		正	① GS間に逆方向電圧を印加することで空乏層の厚さを変化させてドレイン電流量変化させるものが接合型FETである。	
P. 82	[No. 45] 解説文	誤	[No. 45] <FRAM> 正解 2 強誘電体を用いたメモリはFRAMと呼ばれていて、不揮発性(電源を切っても記憶が消えない)メモリである。 強誘電体は、電場がなくても分極が存在する物質である。この分極を自発分極という。また、強誘電体はドメインと呼ばれる領域からなっている。 FRAMは、従来のフラッシュメモリと比べて高速・低電力で書き換えが可能という特徴がある。 よって、正解は肢2である。	2022/02/10
		正	[No. 45] <FeRAM> 正解 2 強誘電体を用いたメモリはFeRAMと呼ばれていて、不揮発性(電源を切っても記憶が消えない)メモリである。 強誘電体は、電場がなくても分極が存在する物質である。この分極を自発分極という。また、強誘電体はドメインと呼ばれる領域からなっている。 FeRAMは、従来のフラッシュメモリと比べて高速・低電力で書き換えが可能という特徴がある。 よって、正解は肢2である。	
P. 94	[No. 70] 解説7行目	誤	となる。ここで、 $v_s(t) = V_s e^{j\omega t}$ 、 $v_o(t) = V_o e^{j\omega t + \phi}$ とおくと $V_o e^{j\omega t + \phi} = -j\omega CR V_s \cdot \underline{e^{j\omega t}}$ であるから、大きさを比較して	2022/02/10
		正	となる。ここで、 $v_s(t) = V_s e^{j\omega t}$ 、 $v_o(t) = V_o e^{j\omega t + \phi}$ とおくと $V_o e^{j\omega t + \phi} = -j\omega CR V_s \cdot \underline{e^{j\omega t + \phi}}$ であるから、大きさを比較して	

※「掲載日」は、上掲訂正情報がLECホームページの『公務員 テキスト改訂・修正情報一覧』(<http://www.lec-jp.com/koumuin/info/teisei/>)に掲載された日付です。